

	<h2 style="color: red;">FQD12N20TM_F080</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD12N20TM_F080</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD12N20TM_F080.pdf 2.FQD12N20TM_F080.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20TM_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FQD12N20TM_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD12N20TM_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD12N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD12N20TM_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD12P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>
 <p>FQD12N20LTM_SN00173 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK</p>	 <p>FQD12N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD12N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD12N20TM_F080 Datenblatt	FQD12N20TM_F080-Datenblätter	FQD12N20TM_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD12N20TM_F080
FQD12N20TM_F080 Electronic	FQD12N20TM_F080-Komponenten	FQD12N20TM_F080-Verteiler	FQD12N20TM_F080-Bild	FQD12N20TM_F080-Teil
FQD12N20TM_F080 Preis	FQD12N20TM_F080 Hersteller	FQD12N20TM_F080 Bild	FQD12N20TM_F080 Aktie	FQD12N20TM_F080 Inventar
FQD12N20TM_F080 Neu	FQD12N20TM_F080 Original	FQD12N20TM_F080 garantiert	FQD12N20TM_F080 RFQ	FQD12N20TM_F080 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited